

课程代号: PHY17017

北京理工大学 2014-2015 学年第一学期

大学物理 II 期末试题 A 卷参考答案及评分标准 (信二学习部整理)

一、填空题(共40分)

- 1. r_1^2/r_2^2 (3 %)
- 2. ε_r (3分)
- 3. 3.08×10⁻¹³ J (3 分)
- 4. 1:16 (3分)
- 5. *IBR* (3分)
- 6. 1.06T (3分)
- 7. 3.1% (3分)
- 8. 0.0732nm (3分)
- 9. 垂直纸面向里; (2分) 垂直 OP 连线向下 (2分)
- 10. 4.5 年; (2分) 0.20年 (2分)
- 11. 0.91c 或 2.73×10⁸ m/s; (2 分) 5.31×10⁻⁸s (2 分)
- 12. $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$; (2 %) $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$ $\not\equiv (2, 0, 0, -\frac{1}{2})$ (2 %)

二、选择题(每题3分,共15分)

D B D B C

三、计算题(共45分)

1解: (1)设x轴沿细线方向,原点在球心处,在x处取线元 dx,其上电荷为 $dq' = \lambda dx$,该线元在带电球面的电场中所受电场力为:

$$dF = q\lambda dx / (4\pi \varepsilon_0 x^2)$$

整个细线所受电场力为:

$$F = \frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \frac{q\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 r_0 (r_0+l)}$$

方向沿x正方向。

(5分)

(2) 电荷元在球面电荷电场中具有电势能:

$$dW = (q\lambda dx)/(4\pi \varepsilon_0 x)$$

整个线电荷在电场中具有电势能:

$$W = \frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{r_0+l}{r_0}\right)$$
 (5 ½)



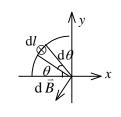
ε

2.解:取 dl 段,其中电流为

$$dI = \frac{I dl}{\frac{1}{2}\pi R} = \frac{2IR d\theta}{\pi R} = \frac{2I d\theta}{\pi}$$

在轴线上任一点P

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0}{2\pi R} \cdot \frac{2I}{\pi} d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} d\theta \qquad (4 \%)$$



选坐标如图

方向: $\operatorname{tg}\alpha = B_{_{\boldsymbol{y}}}/B_{_{\boldsymbol{x}}} = 1$, $\alpha = 225^{\circ}$, α 为 \bar{B} 与 x 轴正向的夹角. (6分)

3. 解: 设线圈回路以 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 的绕向为动生电动势 的正方向,与直导线平行的 AC 边产生的动生电动势

$$\varepsilon_1 = vlB = vl\mu_0 I / (2\pi a)$$
 (2

分)

其它两边产生的动生电动势大小相等绕向相同. 如图所 示,在 CD 边上选一线元 $d\bar{l}$,则其上的动生电动势

$$d \varepsilon_{2} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vB\cos 60^{\circ} dl$$

$$= -v\cos 60^{\circ} \frac{\mu_{0} I dl}{2\pi(a+x)}$$

$$d l \cos 30^{\circ} = d x$$

$$d l \cos 30^{\circ} = d x$$

$$d \varepsilon_{2} = -\frac{v\mu_{0}I}{2\pi} \cdot \frac{\cos 60^{\circ}}{\cos 30^{\circ}} \cdot \frac{d x}{a+x}$$

 $\Rightarrow c = \sqrt{3}l/2$

$$\varepsilon_2 = -\frac{v\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{3}/2} \int_0^c \frac{dx}{a+x} = -\frac{\sqrt{3}\mu_0 I v}{6\pi} \ln \frac{a+c}{a}$$
 (6 \(\frac{\frac{1}}{2}\))

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \left[\frac{l}{a} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \ln \frac{a+c}{a} \right] \tag{2 \%}$$



4解: (1) 由一维无限深方势阱中粒子的能量公式,电子在最低能级的能量为

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 = \frac{\pi^2 \times (1.05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (0.20 \times 10^{-9})^2 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 9.33 \,\text{eV}$$
 (3 $\%$)

(2) 电子处于第一激发态 (n=2) 时, 在势阱内出现的概率为

$$\left|\varphi_{2}\right|^{2} = \left|\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{2\pi}{a}x\right|^{2} = \frac{2}{a}\sin^{2}\frac{2\pi}{a}x$$

对 x 求导数,导数为零处即为电子在势阱中出现的概率取极值的地方

$$\frac{d|\varphi_2|^2}{dx} = \frac{8\pi}{a^2} \sin\frac{2\pi}{a} x \cos\frac{2\pi}{a} x = \frac{4\pi}{a^2} \sin\frac{4\pi}{a} x = 0$$

则有

$$x = \frac{ka}{4}$$
 (k=0, 1, 2, ...)

由已知条件可知,在 x=0nm,0.10nm,0.20nm 处电子出现的概率最小,其值均为零。(7分)

5. 解答: 当等离子柱通有电流时,会在柱体内外产生磁场,在柱体内的磁场是沿径向由内向外逐渐增强的,是一个不均匀磁场。(2分)

在这个不均匀磁场中,由于洛伦兹力的作用,等离子体中运动的带电粒子被推向磁场较弱的轴心区域,即等离子圆柱在内部电流的磁场作用下向轴心收缩。

学习部